# Микро- и мезопористые углеродные наноструктуры с решеткой инвертированного опала\*

© Г.А. Емельченко<sup>1</sup>, В.М. Масалов<sup>1</sup>, А.А. Жохов<sup>1</sup>, И.И. Ходос<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Институт физики твердого тела РАН,

Черноголовка, Московская обл., Россия

<sup>2</sup> Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН,

Черноголовка, Московская обл., Россия

E-mail: emelch@issp.ac.ru

Исследованы условия формирования пористой системы в углеродных наноструктурах с решеткой инвертированного опала. С помощью газовой адсорбции-десорбции определены характеристики пористой структуры. Методами просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения исследованы морфология и структура образцов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-02-00460).

# 1. Введение

Наноструктурные углеродные материалы находят широкое применение во многих областях техники. Наиболее активно развиваются направления, связанные с портативными источниками питания в микроэлектронике, накопителями энергии, компонентами силовых импульсных устройств и других приборов, где существует необходимость быстродействующего источника энергии [1]. Важнейшими параметрами углеродных материалов, используемых в электрохимических источниках питания в качестве электродов, являются площадь удельной поверхности, размеры и топология пор. Высокая площадь удельной поверхности углерода повышает способность к аккумулированию зарядов на его поверхности. Основной вклад в площадь удельной поверхности вносят микропоры (диаметр менее 2 nm) [2]. Для быстрого переноса ионов в объеме электродного материала чрезвычайно важно присутствие мезопор (диаметр от 2 до 50 nm). Взаимосвязанная система микро- и мезопор в сочетании с высокой площадью поверхности электродов повышает выходные характеристики устройств [3]. Среди способов получения наноструктурных углеродных материалов матричный метод синтеза (метод шаблонов) обладает наибольшими возможностями для контроля и управления пористой структурой материала. Этот метод основан на заполнении теми или иными веществами решеток пустот в природных или искусственных матрицах, например опалах. Среди углеродных наноструктур известны, например, молекулярные сита [4], полученные карбонизацией органических соединений внутри мезопористого диоксида кремния, а также углеродная структура с трехмерной периодичностью на основе опаловой решетки [5]. Ряд мезоструктурированных матриц диоксида кремния, таких как MCM48, MCM41, SBA15, заполняют углеродными прекурсорами (раствор сахара, пропилен, смола и др.), карбонизируют и удаляют SiO<sub>2</sub>, помещая в раствор фтористоводородной кислоты [2,6-8]. В этих

и многих других работах мало внимания уделяется изучению влияния температуры процесса и размеров частиц SiO<sub>2</sub> на параметры пористой системы полученных образцов. Как правило, термообработку образцов проводят при температурах 1100-1200 K.

В настоящей работе исследовано влияние термохимической обработки (ТХО) опаловых матриц, заполняемых углеродсодержащими соединениями с последующим удалением из них диоксида кремния, на формирование пористой структуры. Размеры частиц диоксида кремния, составляющих матрицу, варьировались в пределах от 10 до 300 nm. Характеристики пористой структуры определялись с помощью газовой адсорбции-десорбции. Морфология и структура образцов исследовались методами просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР).

#### 2. Экспериментальная часть

Для получения углеродных наноструктур с решеткой инвертированного опала использовались образцы опаловых матриц, приготовленных седиментацией суспензий монодисперсных коллоидных частиц диоксида кремния. Частицы диоксида кремния получали гидролизом тетраэтоксисилана в спирто-водно-аммиачном растворе [9]. Подробности технологии приготовления опаловых матриц приведены в работе [10]. Коллоидные частицы малого размера (10-12 nm) синтезировали гидролизом тетраэтоксисилана в присутствии L-аргинина [11] и осаждали центрифугированием. Следует отметить, что при центрифугировании суспензии образуется разупорядоченная матрица коллоидных частиц SiO2. При карбонизации внутри пор такой матрицы углерод не образует решетку инвертированного опала и может создавать различные структурные мотивы в зависимости от условий термообработки.

Для введения углерода в матрицу использовали водный раствор сахарозы C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub> с добавлением серной кислоты, которым пропитывали образец. Образ-

<sup>\*</sup> Доклад на Всероссийской молодежной конференции "Опалоподобные структуры" (Санкт-Петербург, 23–25 мая 2012 г.).

| Номер<br>образца | Обозначение<br>образца | Диаметр частиц<br>SiO <sub>2</sub> , nm | Температура<br>ТХО, К | Площадь удельной поверхности, m <sup>2</sup> /g | Общий объем пор, cm <sup>3</sup> /g | Объем микро-<br>пор, cm <sup>3</sup> /g | Диаметр пор,<br>nm           |
|------------------|------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1                | SiC/C-IOP              | 300                                     | 1770                  | 180   | 0.57                                | 0.045                                   | 1.0, 3.3, 5.5, 8.8           |
| 2                | SiC/C-IOP(act.)        | 300                                     | 1770                  | 294   | 0.51                                | 0.09                                    | 0.7, 1.5, 2.5, 3.3, 5.7, 8.2 |
| 3                | C-IOP                  | 300                                     | 1200                  | 570   | 0.70                                | 0.21                                    | 0.7, 3.0, 5.7, 8.8           |
| 4                | C-IOP(act.)            | 300                                     | 1200                  | 1448  | 1.72                                | 0.51                                    | 0.7, 1.5, 3.0, 5.7, 8.0      |
| 5                | SiC/C-IOP(act.)        | 73                                      | 1770                  | 2.65  | _                                   | _                                       | 1.9                          |
| 6                | C-IOP                  | 73                                      | 1200                  | 430   | 0.75                                | 0.15                                    | 0.7, 3.1, 11.7               |
| 7                | C-disord.(act.)        | 12                                      | 900                   | 2050  | 0.99                                | 0.81                                    | 0.8, 1.2, 1.4, 1.8, 3.1      |
| 8                | C-disord.(act.)        | 10                                      | 900                   | 2478  | 1.56                                | 0.92                                    | 0.8, 1.4, 3.0                |

Условия термохимической обработки и параметры пористой системы измеренных образцов

Примечание. Площадь удельной поверхности рассчитана методом BET в диапазоне давлений 0.05-0.20. Общий объем пор вычислен по объему адсорбированного азота при  $P/P_0 = 0.99$ . Объем микропор (< 2 nm) и размеры наиболее заметных пор рассчитаны методом DFT в модели щелевых пор QSDFT (quenched solid density functional theory). Ошибка при подгонке составляет 0.3-0.7% для разных изотерм.

цы помещали в водный раствор (на 1 g SiO<sub>2</sub> 1.25 g  $C_{12}H_{22}O_{11}$ , 0.14 g  $H_2SO_4$ , 5 g  $H_2O$ ) и вместе с раствором выдерживали при температуре 100°C около 5 h, затем сушили при температуре 160°C в течение 18 h. После этого образцы повторно пропитывали раствором (1 g SiO<sub>2</sub>:0.8 g  $C_{12}H_{22}O_{11}:0.09$  g  $H_2SO_4:5$  g  $H_2O$ ) и повторяли термообработку. Далее проводили карбонизацию образцов отжигом в потоке аргона в следующих режимах: 900 K/3 h (для опалов с размером частиц 10–15 nm), 1200 K/3 h (для опалов с размером частиц 50–80 nm), 1770 K/3 h в вакууме (для опалов с размером частиц 250–300 nm).

Полученные углеродсодержащие матрицы активировали щелочью КОН по аналогии с работой [12]: образцы помещали в раствор (на 1 g образца 5 ml H<sub>2</sub>O и 2 g KOH) и сушили при температуре 60°С в течение 2h, затем при 110°C в течение 12 h. Термическую обработку проводили при температуре 1070 К в инертной атмосфере 2h. После термообработки образцы промывали сначала в 5 M растворе HCl, затем в дистиллированной воде и сушили при температуре 100°C (12 h). Содержание углерода в исследованных образцах после карбонизации составляло 1.5-5.0 wt.%. После удаления диоксида кремния растворением в плавиковой кислоте образцы содержали 85-90 wt.% углерода. Типичный состав образца для опалов с размером частиц 250-300 nm: 94.3 wt.% C, 4.2 wt.% O, 0.3 wt.% F и 1.2 wt.% Si. Образцы на основе частиц диоксида кремния диаметром 10-12 nm после активации содержали 85.0 wt.% С, 12.7 wt.% O, 0.3 wt.% S, 0.2 wt.% Si и 1.8 wt.% К.

Изотермы адсорбции-десорбции азота регистрировались при 77 К (прибор Quantachrome QuadraWin), по ним определялись характеристики пористой системы. Условия предварительной дегазации образцов были следующими: 300°C, 2 h, He. Для расчета параметров пористой системы использовались стандартные методы: BET (Brunauer, Emmett, Teller), DFT (метод теории функционала плотности, density Functional Theory). Морфология и микроструктура образцов изучались в просвечивающем электронном микроскопе JEM-2100.

# 3. Результаты и обсуждение

Условия ТХО и параметры пористой системы измеренных образцов приведены в таблице.

Образцы условно обозначены как SiC/C-IOP(act.) — SiC/C композит с решеткой инвертированного опала (IOP), активированный гидроксидом калия; C-IOP(act.) — углеродная наноструктура с решеткой инвертированного опала, активированная гидроксидом калия; C-disord.(act.) — углеродная наноструктура с разупорядоченной решеткой, активированная гидроксидом калия. Образцы SiC/C-IOP получаются при высокотемпературной ТХО (1770 К), когда частично происходит синтез карбида кремния при карботермическом восстановлении SiO<sub>2</sub> [13]. Образцы С-ІОР подвергались термообработке при температуре 1200 К, когда образования SiC не происходит. Образцы в таблице, в обозначении которых отсутствует "act.", не проходили процедуру щелочного активирования.

Сопоставление полученных результатов показывает четкую зависимость пористости от диаметра исходных частиц диоксида кремния и температуры карбонизации. При этом для увеличения площади удельной поверхности как размер частиц SiO<sub>2</sub>, так и температура обработки изменяются в одном направлении, а именно снижаются. Естественное объяснение этой зависимости заключается в том, что повышение температуры обработки приводит к спеканию наночастиц, увеличению доли макро- и мезопор в образце и, как следствие, к снижению площади удельной поверхности (ср. образцы № 1 и 3 в таблице). Особенно существенно влияние температуры для частиц SiO<sub>2</sub> размером менее 100 nm (образец № 5 в таблице). Щелочная активация также значительно изменяет пористую структуру. Так, активация в случае образца № 4 приводит к увеличению площади удельной поверхности и объема пор в 2.5 раза по сравнению с аналогичным образцом № 3, для которого активации не проводилось.

На рис. 1 приведены изотермы адсорбции-десорбции азота для трех образцов. Изотерма 1 относится к



Рис. 1. Изотермы (77 К) адсорбции-десорбции азота углеродными наноструктурами на основе инвертированного опала. 1 — образец № 2, 2 — № 4, 3 — № 8. Номера образцов соответствуют приведенным в таблице.



**Рис. 2.** Зависимость площади удельной поверхности от объема микропор для образцов, приведенных в таблице. Прямая проведена для наглядности.

композиту SiC/C с диаметром исходных частиц SiO<sub>2</sub> 300 nm (образец № 2). Изотерма 2 соответствует С-инвертированному опалу с диаметром исходных частиц SiO<sub>2</sub> 300 nm (образец № 4). Изотерма 3 относится к углеродной наноструктуре с разупорядоченной решеткой, активированной гидроксидом калия (диаметр исходных частиц SiO<sub>2</sub> 10 nm, образец № 8). Образцы № 2, 4, 8 проходили ТХО при температурах 1770, 1200 и 900 К соответственно в течение 2 h в вакууме с последующей активацией гидроксидом калия при 1070 К. Изотермы имеют тип II по классификации [14], который отвечает полимолекулярной адсорбции. Петля сорбционного гистерезиса приближается к точке относительного давления  $P/P_0 = 0.4$ , что указывает на преобладание микропор (размер менее 2 nm). Доминирующий вклад микропор в площадь удельной поверхности показывает пропорциональная зависимость между объемом микропор и площадью удельной поверхности (по BET) на рис. 2. Объем микропор в рассматриваемом ряду образцов увеличился в 20 раз, площадь поверхности в 14 раз, а общий объем пор вырос только в 3 раза. Следует отметить, что пропорциональная зависимость между объемом микропор и площадью удельной поверхности соблюдается для всех размеров исходных частиц диоксида кремния в опаловой матрице, используемых в настоящей работе.

Распределение пор по размерам и их вклад в объем пор также свидетельствуют об основном влиянии микропор на площадь удельной поверхности. На рис. 3 представлены кривые распределения пор по размерам для образцов № 2,4 и 8 и соответствующих объемов, аккумулированных в этих порах. Видно, что для образца № 8 (площадь 2478 m<sup>2</sup>/g) кривая набора объема пор с ростом их размера имеет крутой подъем только в области микропор и при размере пор 3 nm выходит на плато (рис. 3, с). Для образцов № 2 и 4 с меньшей площадью удельной поверхности (рис. 3, а, b) аналогичные кривые имеют небольшой крутой участок в области микропор, а в области мезопор кривые плавно поднимаются, не достигая плато. Это указывает на наличие мезопор с широким распределением по размерам. Действительно, для образцов № 2 (рис. 3, а) и № 4 (рис. 3, b) наблюдаются поры размером до 20 nm с широким распределением (по размерам) вокруг каждого максимума. Образец № 8 демонстрирует мезопоры только одного размера 3 nm (рис. 3, *c*), а в образце № 7 выделенных мезопор не наблюдается и доля микропор в общем объеме пор составляет 82%.

Активация щелочью способствует увеличению объема пор и образованию микропор. Анализ экспериментальных данных показывает, что при активации образцов объем микропор и общий объем пор увеличиваются пропорционально для образцов, обработанных при 1200 и 900 К. Для образцов с температурой ТХО 1770 К эта зависимость не всегда соблюдается. Обработка щелочью значительно развивает микропоры размером 0.7 nm и мезопоры около 3 nm. Среди вновь возникающих микропор следует выделить поры размером около 1.4 nm, которые формируются во всех образцах независимо от температуры обработки и размера частиц диоксида кремния. Наиболее рельефно проявляются микропоры размером 1.4 nm в образцах при температуре ТХО 900 К (рис. 3, c). В случае ТХО при 1200 К микропоры диаметром 1.4 nm проявляются в виде плеча на дифференциальной кривой распределения пор по размерам (рис. 3, b), сливаясь с основным пиком при 0.7 nm. Гидроксид калия также способствует развитию микропор размером 1.2 и 1.8 nm (рис. 4, образец № 7). Исследования механизмов взаимодействия гидроксида калия с углеродом указывают на протекание множества реакций с образованием карбонатов калия, возможным восстановлением катионов до металла, с интеркалированием щелочного металла в



**Рис. 3.** Распределение пор и объемов, аккумулированных в этих порах, по размерам для образцов № 2 (a), № 4 (b) и № 8 (c).

межслоевое пространство углеродной матрицы [15–17]. Эти реакции зависят от многих факторов и требуют специального изучения.

Завершая характеризацию углеродных структур методом газовой адсорбции-десорбции, следует выделить среди множества влияющих факторов главные, а именно температуру обработки образцов и размеры частиц диоксида кремния в исходной опаловой матрице. Эти два параметра оказывают решающее влияние на формирование и развитие пористой структуры. Кроме них важнейшее значение для развития микропористой системы имеет щелочная активация образцов с использованием гидроксида калия. Только после активации образцы имеют максимальную площадь удельной поверхности (до 2500 m<sup>2</sup>/g) и максимальный объем пор (до 1.72 cm<sup>3</sup>/g).

Исследования образцов методом ПЭМВР обнаружили в структуре композитов SiC/C (образец № 1) кроме кристаллитов карбида кремния, графита и аморфного углерода сферические частицы углерода, содержащие концентрические графитоподобные оболочки (луковицеобразные, или onion-like, частицы) (рис. 5). Более подробно эти фазы охарактеризованы в предыдущих работах [13,18]. Для образцов, обработанных при температуре 1200 К, луковицеобразные частицы имеют почти сферическую форму, но плохо организованную наноструктуру с малым числом углеродных слоев. Рис. 6, *а* демонстрирует изображение участка образца № 4, где



Рис. 4. Распределение пор по размерам для образца № 7.



Рис. 5. ПЭМВР-изображение участка композита SiC/C (образец № 1), содержащего луковицеобразные (onion-like) частицы.



**Рис. 6.** ПЭМВР-изображения микро- (a) и мезопор (b) в образце № 4.

рамкой выделена частица с тремя графитоподобными слоями в оболочке и незаполненным ядром диаметром около 1.5 nm. Известные механизмы синтеза луковицеобразных частиц, такие как формирование при электронном облучении [19], при имплантации углеродных ионов [20], при высокотемпературном отжиге частиц алмаза [21], не позволяют объяснить образование этих частиц при синтезе углеродных наноструктур в наших экспериментах. Выяснение этого механизма требует дальнейших исследований.

На рис. 6, *b* показан участок образца № 4 с мезопорой шириной около 3 nm (в рамке). Из сорбционного анализа следует, что в образцах с большой площадью удельной поверхности наиболее развиты поры размером  $\sim 0.7$ ,  $\sim 1.5$  и  $\sim 3.0$  nm. Можно предположить, что именно поры размером  $\sim 1.5$  и  $\sim 3.0$  nm соответствуют структурным аналогам, показанным на рис. 6, *а* и *b* соответственно. Что касается микропор размером  $\sim 0.7$  nm, то они могут иметь вакансионную природу или быть обусловленными интеркалированием калия в углеродную решетку [22].

# 4. Заключение

Исследовано влияние термохимической обработки опаловых матриц, заполняемых углеродными соединениями с последующим растворением диоксида кремния, на формирование пористой структуры. Показано, что температура обработки образцов и размеры частиц диоксида кремния в исходной опаловой матрице оказывают решающее влияние на формирование и развитие пористой структуры.

Важнейшее значение для развития микропористой системы имеет щелочная активация образцов с использованием гидроксида калия. Только после активации образцы имеют максимальную площадь удельной поверхности (до  $2500 \text{ m}^2/\text{g}$ ) и максимальный объем пор (до  $1.72 \text{ cm}^3/\text{g}$ ).

Методом ПЭМВР в образцах обнаружены луковицеобразные углеродные наночастицы, образованные в процессе высокотемпературной термохимической обработки, механизм образования которых не определен. Сделано предположение, что сорбционные поры размером ~ 1.5 nm могут быть обусловлены пустотами, наблюдаемыми в ядре луковицеобразных наночастиц. Углеродные наноструктуры с большой площадью удельной поверхности перспективны в качестве сорбентов, сенсоров, катализаторов и электродных материалов.

Авторы благодарят Е.Н. Кабачкова за помощь в измерении изотерм сорбции образцов, Н.С. Сухинину за подготовку образцов.

### Список литературы

- F. Beguin, E. Frackowiak. In: Nanomaterials Handbook / Ed. Yu. Gogotsi. CRC Press (2006). Ch. 26. P. 295.
- [2] C. Vix-Guterl, E. Frackowiak, K. Jurewicz, M. Friebe, J. Parmentier, F. Beguin. Carbon 43, 1293 (2005).
- [3] D. Qu, H. Shi. J. Power Sourcing 74, 99 (1998).
- [4] R. Ryoo, S.H. Joo, Sh. Jun. J. Phys. Chem. B 103, 7743 (1999).
- [5] A.A. Zakhidov, R.H. Baughman, Z. Iqbal, C. Cui, I. Khayrullin, S.O. Dantas, J. Marti, V.G. Ralchenko. Science 282, 897 (1998).
- [6] K. Jurewicz, C. Vix, E. Frackowiak, S. Saadallach, M. Reda, J. Parmentier, J. Patarin, F. Béguin. J. Phys. Chem. Solids 65, 287 (2004).
- [7] S. Yoon, J. Lee, T. Hyeon, S.M. Oh. J. Electrochem. Soc. 147, 2507 (2000).
- [8] S. Jun, S.H. Joo, R. Ryoo, M. Kruk, M. Jaroniec, Z. Liu, T. Ohsuna, O. Terasaki. J. Am. Chem. Soc. **122**, 10712 (2000).
- [9] W. Stober, A. Fink, E. Bohn. J. Coll. Interface Sci. 26, 62 (1968).
- [10] И.И. Бардышев, А.Д. Мокрушин, А.А. Прибылов, Э.Н. Самаров, В.М. Масалов, И.А. Карпов, Г.А. Емельченко. Коллоид. журн. 68, 20 (2006).
- [11] В.М. Масалов, Н.С. Сухинина, Г.А. Емельченко. ФТТ 53, 1072 (2011).
- [12] D. Lozano-Castello, M.A. Lillo-Rodenas, D. Cazorla-Amoros, A. Linares-Solano. Carbon 39, 741 (2001).
- [13] Г.А. Емельченко, В.М. Масалов, А.А. Жохов, М.Ю. Максимук, Т.Н. Фурсова, А.В. Баженов, И.И. Зверькова, С.С. Хасанов, Э.А. Штейнман, А.Н. Терещенко. ФТТ 53, 1059 (2011).

- [14] S. Brunauer, P.H. Emmett, E. Teller. J. Am. Chem. Soc. 60, 309 (1938).
- [15] A. Robau-Sanchez, F. Cordero-de la Rosa, J. Aguilar-Pliego, A. Aguilar-Elguezabal. J. Porous Mater. 13, 1123 (2006).
- [16] T. Otowa, R. Tanibata, M. Itoh. Gas Separ. Purif. 7, 241 (1993).
- [17] В.А. Кучеренко, Т.Г. Шендрик, Т.В. Хабарова, Ю.В. Тамаркина. Журн. СФУ. Сер. Химия **2**, *3*, 223 (2009).
- [18] А.Н. Терещенко, В.И. Зиненко, И.И. Ходос, Ю.А. Агафонов, А.А. Жохов, В.М. Масалов, Э.А. Штейнман, Г.А. Емельченко. ФТТ 54, 549 (2012).
- [19] F. Banhart, T. Fuller, Ph. Redlich, P.M. Ajayan. Chem. Phys. Lett. 269, 349 (1997).
- [20] T. Cabioch, J.P. Riviere, J. Delafond. J. Mater. Sci. 30, 4787 (1995).
- [21] V.L. Kuznetsov, A.L. Chuvili, E.M. Moroz, V.N. Kolomiichuk, Sh.K. Shaikhutdinov, Yu.V. Butenko, I.Yu. Mal'kov. Carbon 32, 873 (1994).
- [22] Л.А. Бован, Т.Т. Цыба, Ю.В. Тамаркина, В.А. Кучеренко. Сб. науч. тр. ДонНТУ. Сер. Химия и химическая технология. ДонНТУ, Донецк (2009). В. 152. С. 94.